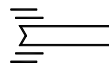


Микросхемы интегральные 198НТ1АТВК, 198НТ1БТВК, 198НТ1ВТВК, 198НТ1АТ1ВК, 198НТ1БТ1ВК, 198НТ1ВТ1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР.431410.245 ТУ; ОСМ198НТ1АТ1ВК, ОСМ198НТ1БТ1ВК, ОСМ198НТ1ВТ1ВК соответствуют техническим условиям АЕЯР. 431410.245 ТУ и ПО.070.052 и признаны годными для эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ВНИМАНИЕ-Соблюдайте меры предосторожности при работе – ПРИБОРЫ, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ».

Допустимое значение статического потенциала 200 В.



МИКРОСХЕМЫ 198НТ1АТВК, 198НТ1БТВК, 198НТ1ВТВК, 198НТ1АТ1ВК, 198НТ1БТ1ВК, 198НТ1ВТ1ВК, ОСМ198НТ1АТ1ВК, ОСМ198НТ1БТ1ВК, ОСМ198НТ1ВТ1ВК

Код ОКП:

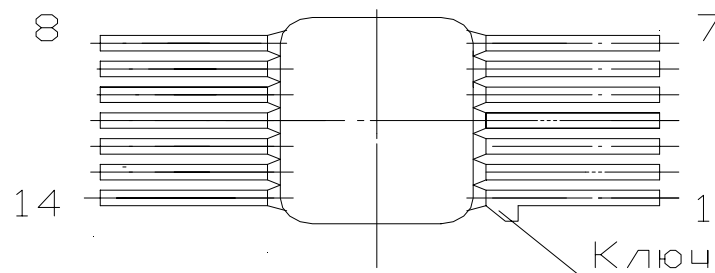
6331328235 – 198НТ1АТВК; 6331328245 – 198НТ1АТ1ВК, ОСМ198НТ1АТ1ВК
6331328275 – 198НТ1БТВК; 6331328285 – 198НТ1БТ1ВК, ОСМ198НТ1БТ1ВК
6331328315 – 198НТ1ВТВК; 6331328325 – 198НТ1ВТ1ВК, ОСМ198НТ1ВТ1ВК

ЭТИКЕТКА

САРЛ.431130.030 ЭТ1

Микросхемы интегральные 198НТ1АТВК, 198НТ1БТВК, 198НТ1ВТВК, 198НТ1АТ1ВК, 198НТ1БТ1ВК, 198НТ1ВТ1ВК, ОСМ198НТ1АТ1ВК, ОСМ198НТ1БТ1ВК, ОСМ198НТ1ВТ1ВК – матрица транзисторов NPN типа.

Схема расположения выводов

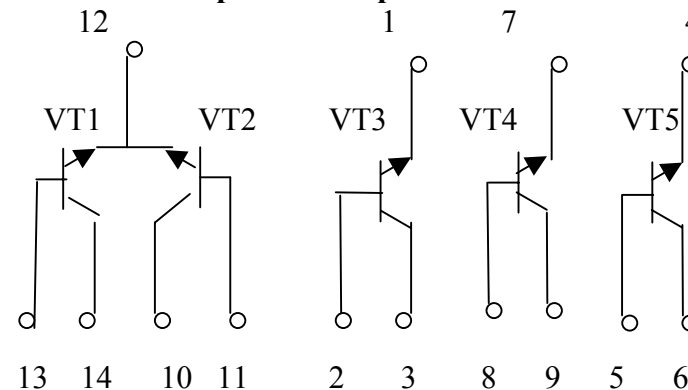


Нумерация выводов показана условно.

Ключ показывает начало отсчета выводов.

Масса не более 0,8 г.

Схема электрическая принципиальная



**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
при температуре (25±5) °С**

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма					
		198НТ1АТ1ВК 198НТ1АТ1ВК ОСМ198НТ1АТ1ВК		198НТ1БТ1ВК 198НТ1БТ1ВК ОСМ198НТ1БТ1ВК		198НТ1ВТ1ВК 198НТ1ВТ1ВК ОСМ198НТ1ВТ1ВК	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока при: $U_{CB}=3$ В; $I_E=-0,5$ мА при: $U_{CB}=3$ В; $I_E=-0,05$ мА	h_{21E}	30 -	200 -	30 -	200 -	- 50	- 250
Обратный ток эмиттера, нА	I_{EBO}	-	100	-	100	-	100
Ток утечки, нА	I_L	-	50	-	50	-	50
Обратный ток коллектора, мкА, при: $U_{CB}=6$ В	I_{CBO}	-	0,05	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер, В, при: $I_C=3$ мА; $I_B=0,5$ мА	$U_{BE sat}$	-	0,8	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, при: $I_C=3$ мА; $I_B=0,5$ мА	$U_{CE sat}$	-	0,2	-	0,2	-	0,2
Разброс статических коэффициентов передачи тока (транзисторов VT1, VT2), %, при: $U_{CB}=3$ В; $I_E=-0,5$ мА	Δh_{21E}	-	15	-	15	-	15
Разброс напряжения база-эмиттер (транзисторов VT1, VT2), мВ, при: $U_{CB}=3$ В; $\Sigma I_E=0,5$ мА	ΔU_{BE}	-	3	-	10	-	3

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:
- золото –

Цветных металлов не содержится.

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка (Тнм) микросхем в режимах и условиях допускаемых ТУ, - 100000 ч, а в следующих облегченных режимах при напряжениях, токах и мощностях, не превышающих 60 % от предельных значений – 120000 ч.

Гамма-процентный ресурс (Тр γ) микросхем при $\gamma=95\%$ 200000 ч

Минимальный срок сохраняемости микросхем (Тсм) при их хранении:

- в отапливаемом хранилище или в хранилище с регулируемой влажностью и температурой или местах хранения микросхем, смонтированных в защищенную аппаратуру, или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, - 25 лет;
- в неотапливаемом хранилище – 16,5 лет;
- под навесом и на открытой площадке, смонтированными в аппаратуру (в составе незащищенного объекта), или в комплекте ЗИП – 12,5 лет.

Срок сохраняемости исчисляется с даты изготовления, указанной на микросхеме.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых микросхем всем требованиям АЕЯР.431410.245 ТУ; а микросхем с индексом «ОСМ» - АЕЯР.431410.245 ТУ и ПО.070.052 в течение срока сохраняемости и минимальной наработки в пределах срока сохраняемости при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных ТУ.

Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхеме.